

## PNP 中功率放大三极管 PNP Medium Power Transistor

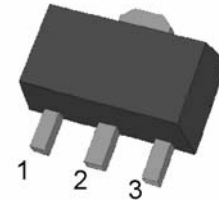
### PNP Medium Power Transistor PNP 中功率放大三极管

### FHFCX591

#### DESCRIPTION & FEATURES 概述及特点

Complement to FHFCX491

SOT-89



#### PIN ASSIGNMENT 引脚说明

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-89	
B	1	BASE
C	2	COLLECTOR
E	3	EMITTER

#### MAXIMUM RATINGS(T<sub>a</sub>=25°C) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	V <sub>CEO</sub>	-60	Vdc
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	V <sub>CBO</sub>	-80	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	V <sub>EBO</sub>	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集电极电流-连续	I <sub>C</sub>	-1.0	Adc

#### THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Power Dissipation 耗散功率	P <sub>tot</sub>	-1	W
Operating and Storage Temperature Range 储存温度	T <sub>J</sub> :T <sub>stg</sub>	-65 ~150	°C

#### DEVICE MARKING 打标

FHFCX591=P1(100~300)

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

(T<sub>A</sub>=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	V <sub>(BR)CEO</sub>	I <sub>C</sub> =-10mA,	-60	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	V <sub>(BR)CBO</sub>	I <sub>C</sub> =-100μA	-80	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	V <sub>(BR)EBO</sub>	I <sub>E</sub> =-100μA	-5.0	—	—	V
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =-60V	—	—	-100	nA
	I <sub>CES</sub>	V <sub>CE</sub> =-60V	—	—	-100	
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =-4V	—	—	-100	nA
DC Current Gain 直流电流增益	h <sub>FE1</sub>	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-1mA	100	—	—	
	h <sub>FE2</sub>	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-500mA	100	—	300	
	h <sub>FE3</sub>	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-1.0A	80	—	—	
	h <sub>FE4</sub>	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-2.0A	15	—	—	

## PNP Medium Power Transistor

## PNP 中功率放大三极管

## FHFCX591

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$	—	—	-300	mV
		$I_C=-1A, I_B=-100mA$	—	—	-600	mV
Base-Emitter Saturation Voltage 基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-1A, I_B=-100mA$	—	—	-1.2	V
Base-Emitter Turn on Voltage 基极-发射极开启电压	$V_{BE(on)}$	$I_C=-1A, V_{CE}=-5V$			-1.0	V
Transition Frequency 特征频率	$f_T$	$V_{CE}=-10V, I_E=-50mA, f=100MHZ$	150	—	—	MHz
Collect Output Capacitance 输出电容	$C_{Ob}$	$V_{CB}=-10V, f=1MHZ$	—	—	10	pF